



中華民國專利證書

發明第 I 335674 號

發明名稱：於碳化矽基板上形成絕緣層之方法、碳化矽電晶體及其製造方法

專利權人：國立台灣大學

發明人：胡振國、莊凱傑

專利權期間：自2011年1月1日至2027年7月10日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長 王美花

中華民國

1

月

1

日

